ロ　ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の（一）から（三）までの全てに該当するもの
（一）　磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三度超のもの
（二）　（略）
（三）　超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下二六八・九五度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度が全ての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの
ハ　超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一五度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの
十一～十六　（略）
十七　次のいずれかに掲げる合金の粉末又は金属の粉末であって、表面が接種剤でコーティングされているもの（第七号に該当するものを除く。）
イ　高エントロピー合金
ロ　耐火性のある金属又はその合金

第六条　輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一　集積回路（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの
イ～カ　（略）
ヨ　一つ以上のデジタルプロセッサユニットを有するものであって合計処理性能（ＴＰＰ）が六、〇〇〇以上のもの
二～八の四　（略）
九　サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもののうち、次のイ及びロに該当するもの
イ　チャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の二乗平均平方根がフルスケールの二パーセント未満のもの
ロ　いずれかのチャネルの上限三デシベル周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの

ロ　ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの
（一）　磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三一度超のもの
（二）　（略）
（三）　超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下二六八・九六度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度がすべての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの
ハ　超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一六度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの
十一～十六　（略）
（新設）

第六条　輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一　集積回路（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの
イ～カ　（略）
ヨ　揮発性メモリを含まない他の集積回路との間の全ての入力及び出力にわたる双方向の転送速度の総計が六〇〇ギガバイト毎秒以上である集積回路であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらに該当するようにプログラムが可能なもの
（一）　合計処理性能（ＴＰＰ）が六、〇〇〇以上である機械語命令を実行するデジタルプロセッサユニットを一つ以上有するもの
（二）　（一）で指定された機械語命令の実行に寄与するユニットを除き、合計処理性能（ＴＰＰ）が六、〇〇〇以上であるデジタル基本演算ユニットを一つ以上有するもの
（三）　合計処理性能（ＴＰＰ）が六、〇〇〇以上であるアナログ基本演算ユニットを一つ以上有するもの
（四）　（一）から（三）までのデジタルプロセッサユニットと基本演算ユニットの組み合わせであって、それらの合計処理性能（ＴＰＰ）の総和が六、〇〇〇以上であるものを有するもの
二～八の四　（略）
九　サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもののうち、いずれかのチャネルの入力三デシベル帯域幅が六〇ギガヘルツ以上の場合において、そのチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の二乗平均平方根がフルスケールの二パーセント未満のもの
（新設）